### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

PCT

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro

# OMPI (10) International



## (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 26. Januar 2012 (26.01.2012)

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2012/010314 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation: H01L 31/0224 (2006.01) C23C 4/12 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/003668
- (22) Internationales Anmeldedatum:

22. Juli 2011 (22.07.2011)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

DE

(30) Angaben zur Priorität:

10 2010 032 187.7 23. Juli 2010 (23.07.2010)

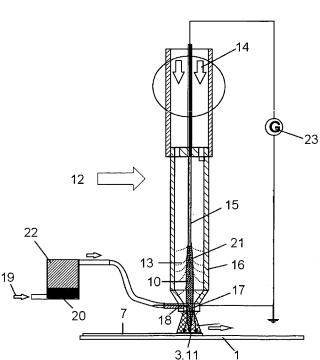
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): REINHAUSEN PLASMA GMBH [DE/DE]; Weidener Strasse 20, 93057 Regensburg (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BISGES, Michael [DE/DE]; Laberstraße 40 a, 93161 Sinzing (DE).
- (74) Anwälte: REICHERT, Werner, F. et al.; Reichert & Kollegen, Bismarckplatz 8, 93047 Regensburg (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING A SOLAR CELL AND SOLAR CELL
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SOLARZELLE UND SOLARZELLE



Figur 4

- (57) Abstract: The invention relates to a method for producing a solar cell having an active front facing the sun, and a back comprising at least one back contact, comprising the application of a back metallization to the back facing away from the sun, and the application in sections of a metal layer for the formation of at least one back contact. Such a method for producing a solar cell, the efficiency of which is improved and the manufacturing costs of which are reduced because of energy and material savings, is characterized in that first the back metallization is applied to the back of the solar cell, and subsequently the metal layer is applied in sections on the back metallization, for the formation of the back contact with the aid of a method for coating a surface using a low temperature plasma jet. The invention further relates to a solar cell which can be produced by the aforementioned method.
- **(57) Zusammenfassung**: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit einer aktiven,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

## WO 2012/010314 A1

- hinsichtlich der Identität des Erfinders (Regel 4.17 Ziffer i)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 Ziffer iii)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
   3)
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
  Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

der Sonne zugewandten Vorderseite und einer Rückseite, die mindestens einen Rückseitenkontakt aufweist, umfassend das Aufbringen einer Rückseitenmetallisierung auf die der Sonne abgewandete Rückseite und das bereichsweise Aufbringen einer metallischen Schicht zur Ausbildung mindestens eines Rückseitenkontaktes. Ein derartiges Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle, deren Effizienz verbessert und deren Herstellkosten aufgrund von Energie- und Materialeinsparungen reduziert sind, zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst die Rückseitenmetallisierung auf die Rückseite der Solarzelle aufgebracht wird und anschließend die metallische Schicht zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes mit Hilfe eines Verfahrens zur Beschichtung einer Oberfläche unter Verwendung eines Strahls eines Niedertemperaturplasmas bereichsweise auf die Rückseitenmetallisierung aufgebracht wird. Außerdem betrifft die Erfindung eine Solarzelle, die durch das vorgenannte Verfahren herstellbar ist.

WO 2012/010314 PCT/EP2011/003668

#### Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle und Solarzelle

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit einer aktiven, der Sonne zugewandten Vorderseite und einer Rückseite, die mindestens einen Rückseitenkontakt aufweist, umfassend zunächst das Aufbringen einer Rückseitenmetallisierung auf die der Sonne abgewandete Rückseite der Solarzelle und das anschließende bereichsweise Aufbringen einer metallischen Schicht auf die Rückseitenmetallisierung zur Ausbildung mindestens eines Rückseitenkontaktes. Außerdem betrifft die Erfindung eine durch das Verfahren herstellbare Solarzelle.

10

Solarzellen wandeln Licht in elektrische Energie. Die 15 Solarzelle bildende Halbleiter weisen Bereiche unterschiedlicher Polarität auf. Beispielsweise ist ein Emitterbereich mit einer ersten Polarität aus einem n-Typ-Halbleiter gebildet, wohingegen ein Basisbereich mit einer zweiten Polarität aus einem P-Typ-Halbleiter gebildet ist. Durch den an der Grenzfläche zwischen den Bereichen 20 unterschiedlicher Polarität gebildeten pn-Übergang werden Ladungsträgerpaare, die bei der Absorption auftreffenden Lichts gebildet werden, getrennt. Um die derart getrennten Ladungsträger einem externen Stromkreis zuführen zu können, weist jede Solarzelle Kontakte auf. Abhängig von der 25 Anordnung dieser Kontakte spricht man von Rückseitenkontakten und Vorderseitenkontakten. Um mehrere Solarzellen zu einem Solarmodul zu verschalten, werden die Solarzellen durch an den Kontakten angelötete Lötbänder elektrisch miteinander 30 verbunden.

Die Solarzellen werden bisher wie folgt hergestellt:

WO 2012/010314 2 PCT/EP2011/003668

- Auf der Rückseite der Solarzelle aus Silizium wird bereichsweise eine metallische Schicht in Form einer silberhaltigen Paste dort aufgebracht, wo die Rückseitenkontakte liegen sollen. Das Aufbringen erfolgt im Wege des Siebdrucks.
- Anschließend wird die metallische Schicht in einem Heißluftofen getrocknet.

5

35

- Sodann wird die Rückseitenmetallisierung in Form einer Aluminium-Paste auf die Rückseite der Solarzelle aufgebracht, wobei die Bereiche der Rückseitenkontakte ausgespart werden. Das Aufbringen der Rückseitenmetallisierung erfolgt ebenfalls im Wege des Siebdrucks.
- In einem Trocknungsprozess im Heißluftofen wird die aufgebrachte Aluminiumpaste zur Ausbildung der Rückseitenmetallisierung bei einer ersten Temperatur T1 getrocknet.
- Schließlich wird ein Firing-Prozess bei einer zweiten, gegenüber der ersten Temperatur T1 höheren Temperatur T2 von oberhalb 700 Grad Celsius durchgeführt. Die bei diesem Prozess eintretende Legierungsbildung zwischen dem Aluminium der Rückseitenmetallisierung und dem Silizium der Solarzelle führt zu einer für die Funktion der Solarzelle notwendigen Dotierung des Siliziums.
- 30 Das bekannte Verfahren weist folgende Nachteile auf:
  - Die schlechte elektrische Leitfähigkeit der Pasten muss durch eine Wärmebehandlung im Heißluftofen (thermisches Sintern) verbessert werden, womit ein hoher Energieaufwand verbunden ist.

WO 2012/010314 PCT/EP2011/003668

- Da die silberhaltige Paste zur Ausbildung der Rückseitenkontakte unmittelbar auf der Rückseite der Solarzelle aufgebracht wird, findet in den Bereichen der Rückseitenkontakte keine Legierungsbildung zwischen der Rückseitenmetallisierung aus Aluminium und dem Silizium der Solarzelle statt, wodurch die Effizienz der Solarzelle in den Bereichen der Rückseitenkontakte deutlich gemindert ist.
- 10 Die silberhaltige Paste zur Ausbildung der Rückseitenkontakte ist für die Volumenproduktion von Solarzellen außerordentlich kostspielig.
- Die US 5 178 685 A offenbart ein weiteres Verfahren zur 15 Herstellung einer Solarzelle, bei dem auf einem Silizium-Substrat zunächst eine Rückseiten-Metallisierung in Form einer Aluminiumpaste mit rechteckigen Aussparungen aufgebracht wird. Nach dem Aufbringen wird die Aluminiumpaste in einem Firing-Prozess auf etwa 670 - 850 Grad Celsius 20 erhitzt, damit die Rückseiten-Metallisierung in das Silizium-Substrat einlegiert. Zur Ausbildung von Lötkontakten wird in einem nächsten Schritt eine Silberpaste auf diejenigen Bereiche mit den Aussparungen in der Aluminiumschicht aufgebracht, wobei die Silberpaste die Aluminiumschicht an 25 den Rändern der Aussparungen geringfügig überlappt. Die Silberpaste wird anschließend bei einer gegenüber dem Firing-Prozess geringeren Temperatur getrocknet. Die derart gebildeten Lötkontakte sind mit dem Silizium-Substrat und der Aluminiumschicht elektrisch leitend verbunden.

30

35

5

Die US 2001 / 0 035 129 Al offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle, bei dem auf der Rückseite der Solarzelle eine Metallisierung mit Hilfe eines Plasmastrahls aufgebracht wird. In den Plasmastrahl wird Metallpulver, z.B. aus Aluminium, eingebracht. Sofern zusätzliche metallische Lötkontakte erforderlich sind, wird im Wege des

WO 2012/010314 4 PCT/EP2011/003668

Plasmaspritzens der metallische Kontakt auf die zuvor aufgebrachte Rückseiten-Metallisierung aufgebracht. Als Vorteil des Plasmaspritzprozesses wird angegeben, dass die beim Stand der Technik erforderlichen Trocknungsschritte der Metallpasten nicht mehr erforderlich sind und die Metallabscheidung ausschließlich im Wege des Plasmaspritzens und in einem Schritt erfolgt.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit verbesserter Effizienz und Haftung der Rückseitenkontakte an der Rückseitenmetallisierung zu schaffen. Des Weiteren soll eine Solarzelle mit verbesserter Effizienz und Haftung der Rückseitenkontakte vorgeschlagen werden.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs erwähnten Art dadurch gelöst, dass die metallische Schicht zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes mit Hilfe eines Verfahrens zur Beschichtung einer Oberfläche unter Verwendung eines Strahls eines Niedertemperaturplasmas bereichsweise aufgebracht wird und die Rückseitenmetallisierung mit mindestens einer bis zur Rückseite der Solarzelle reichenden Öffnung aufgebracht wird, wobei jedem Rückseitenkontakt mindestens eine Öffnung zugeordnet wird.

20

25

Außerdem wird diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs erwähnten Art dadurch gelöst, dass die metallische Schicht zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes mit Hilfe eines Verfahrens zur Beschichtung einer Oberfläche unter Verwendung eines Strahls eines Niedertemperaturplasmas bereichsweise aufgebracht wird und die Rückseitenmetallisierung vollflächig auf die Rückseite aufgebracht wird und vor dem Aufbringen der Schicht zur Ausbildung des Rückseitenkontakts mindestens eine bis zur Rückseite der Solarzelle reichende Öffnung in die

WO 2012/010314 5 PCT/EP2011/003668

Rückseitenmetallisierung eingebracht wird, wobei jedem Rückseitenkontakt mindestens eine Öffnung zugeordnet wird.

Eine Solarzelle mit verbesserter Effizienz und Haftung der Rückseitenkontakte ergibt sich aus den Ansprüchen 10 und 11.

Das Beschichtungsverfahren unter Verwendung eines Strahls eines Niedertemperaturplasmas bewirkt eine gut leitfähige Anbindung des Rückseitenkontaktes an die

10 Rückseitenmetallisierung. Die nachfolgend genannten Beschichtungsmaterialien bauen eine gute Haftung zu der Rückseitenmetallisierung aus Aluminium auf und weisen eine gute Lötfähigkeit auf, um die Solarzellen mittels Lötbändern zu Modulen zu verschalten.

15

5

Die Haftfestigkeit der Rückseitenkontakte wird verbessert, indem die Rückseitenmetallisierung mit mindestens einer bis zur Rückseite der Solarzelle reichenden, kleinflächigen Öffnung aufgebracht wird, wobei jedem Rückseitenkontakt 20 mindestens eine Öffnung zugeordnet wird. Alternativ wird die Rückseitenmetallisierung zunächst vollflächig auf die Rückseite aufgebracht und anschließend wird die mindestens eine bis zur Rückseite der Solarzelle reichende kleinflächige Öffnung in die Rückseitenmetallisierung eingebracht. Die 25 Ouerschnittsfläche der jedem Rückseitenkontakt zugeordneten Öffnung(en) sollte deutlich kleiner als die Fläche des Rückseitenkontaktes sein, wobei dessen Fläche die Querschnittsfläche sämtlicher ihm zugeordneten Öffnungen in der Rückseitenmetallisierung mindestens um den Faktor 2 30 übersteigt. In Folge dessen führen diese Öffnungen in der Rückseitenmetallisierung nur in geringem Maße zu einer verschlechterten Effizienz der Solarzelle in diesen Bereichen. Die Öffnungen verbessern jedoch die Haftung der Rückseitenkontakte an der Rückseite der Solarzelle, in dem 35 sie eine mechanische Verankerung des Rückseitenkontaktes an der Rückseite der Solarzelle ermöglichen.

WO 2012/010314 6 PCT/EP2011/003668

Eine weitere Verbesserung der Haftung an der Rückseitenmetallisierung aus Aluminium bei gleichzeitiger Verbesserung der Lötfähigkeit wird erreicht, wenn mehrere metallische Schichten zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes auf die Rückseitenmetallisierung aufgebracht werden.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens eignen sich Niedertemperaturplasmen, deren Plasmastrahl in der Kernzone 10 eine Gastemperatur von weniger als 900 Grad Celsius, insbesondere jedoch von weniger als 500 Grad Celsius aufweist. Bei dem verwendeten Niedertemperaturplasma handelt es sich um ein so genanntes Atmosphärendruckplasma, bei welchem der Druck ungefähr dem der umgebenden Atmosphäre 15 entspricht. Der wesentliche Vorteil des Atmosphärendruckplasmas besteht darin, dass im Gegensatz zum Niederdruck- oder Hochdruckplasma kein Reaktor erforderlich ist, der für die Aufrechterhaltung eines zum Atmosphärendruck unterschiedlichen Druckniveaus sorgt. In Folge dessen lassen 20 sich Verfahren mit Atmosphärendruckplasmen direkt in die Produktion zur Herstellung der Solarzelle integrieren. Kostenintensive Reaktoren zur Erzeugung eines Unterdrucks sind nicht erforderlich.

Die Effizienz der Solarzelle wird dadurch verbessert, dass zunächst die Rückseitenmetallisierung auf die Rückseite der Solarzelle aufgebracht wird. Erst anschließend wird die metallische Schicht zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes bereichsweise auf die Rückseitenmetallisierung aufgebracht.

Die Legierungsbildung zwischen dem Material der Solarzelle, insbesondere dem Silizium, und der Rückseitenmetallisierung, insbesondere Aluminium, findet daher auf einer größeren Oberfläche als bei herkömmlichen Solarzellen statt. Hieraus resultiert eine Steigerung des Gesamtwirkungsgrades der Solarzelle gegenüber einer herkömmlich hergestellten Solarzelle um etwa 0,1 bis 0,3 %.

WO 2012/010314 7 PCT/EP2011/003668

Eine Verbesserung der Energieeffizienz bei der Herstellung der Solarzellen resultiert daraus, dass die Rückseitenkontakte erst nach dem Aufbringen der Rückseitenmetallisierung auf deren Oberfläche mit Hilfe eines 5 Plasmastrahls abgeschieden werden. In Folge dessen ist kein zusätzlicher Trocknungsschritt zum Trocknen der Rückseitenkontakte vor dem Aufbringen der Rückseitenmetallisierung erforderlich. In dem herkömmlichen Prozess ist es indes erforderlich, die silberhaltige Paste 10 zur Ausbildung der Rückseitenkontakte zunächst vollständig zu trocknen, bevor die Aluminiumpaste zur Ausbildung der Rückseitenkontakte aufgebracht und wiederum getrocknet werden muss. Erst anschließend kann der nach dem Aufbringen der 15 Rückseitenmetallisierung notwendige Firing-Prozess zur Legierungsbildung und Dotierung durchgeführt werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist ein sich an das Aufbringen der Rückseitenmetallisierung anschließender Firing-Prozess bereits abgeschlossen, wenn die 20 Rückseitenkontakte abgeschieden werden. Da der Firing-Prozess mit Temperaturen oberhalb von 700 Grad Celsius zum Zeitpunkt des Aufbringens der metallischen Schichten zur Ausbildung der Rückseitenkontakte bereits abgeschlossen ist, können die 25 Rückseitenkontakte aus preiswerteren, insbesondere einen tieferen Schmelzpunkt aufweisenden Metallen hergestellt werden, deren Einsatz sich beim Stand der Technik aufgrund des zwingend nachgeschalteten Firing-Prozesses verbietet. In Betracht kommt insbesondere eines der Metalle Zinn, Silber, 30 Zink, Kupfer oder eine Mischung der vorgenannten Metalle.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Figuren näher 5 erläutert. Es zeigen:

- Figur 1 a) eine Vorderansicht einer herkömmlichen Solarzelle,
- 10 **Figur 1 b)** eine Ansicht der Rückseite der Solarzelle nach Figur 1 a),
  - Figur 1 c) einen Schnitt durch die Solarzelle nach den Figuren 1 a) und 1 b),
- Figur 2 a) eine Ansicht der Rückseite einer mit einem
  Niedertemperatur- Plasmastrahl hergestellten
  Ausführungsform einer Solarzelle,
- 20 Figur 2 b) einen Schnitt durch die Solarzelle nach Figur 2 a),
- Figur 3 a) eine Ansicht der Rückseite einer nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Ausführungsform einer Solarzelle,
  - Figur 3 b)

15

30

- Figur 3 c) unterschiedliche Ausführungsformen von Öffnungen in der Rückseitenmetallisierung für eine Solarzelle nach Figur 1 a),
  - Figur 3 d) einen Schnitt durch die Struktur nach Figur 3 b),
- 35 **Figur 3 e)** einen Schnitt durch die Solarzelle nach Figur 3 a),

WO 2012/010314 9 PCT/EP2011/003668

Figur 4 eine schematische Darstellung einer Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

5

10

15

Die in Figur 1 dargestellte Solarzelle (1) weist auf ihrer Rückseite (2) längliche Rückseitenkontakte (3) auf, die unmittelbar auf die Rückseite (2) der aus Silizium bestehenden Solarzelle (1) aufgebracht sind. Auf der aktiven, der Sonne zugewandten Vorderseite (4) befindet sich ein Vorderseitenkontakt (5). Um die Entfernung, die die Ladungsträger lateral in der Ebene der Solarzelle (1) zurücklegen müssen, um zu einem Kontakt (3, 5) zu gelangen, möglichst gering zu halten, gehen von den Kontakten mehrere Kontaktfinger (6) aus. Die Kontaktfinger (6) sind im wesentlichen über die gesamte Fläche der Solarzelle (1) gleichmäßig verteilt. In dem Ausführungsbeispiel sind die Kontakte (3, 5) als längliche, quer zu den Metallfingern (6) verlaufende Streifen ausgestaltet.

20

Die in Figur 1 dargestellte Solarzelle (1) wird hergestellt, indem zunächst eine hoch silberhaltige Paste in Form der Rückseitenkontakte (3), linienförmig auf das Silizium der Solarzelle (1) im Siebdruckverfahren aufgedruckt wird. 25 Anschließend erfolgt eine Trocknung in einem Heißluftofen. Sodann wird eine Rückseitenmetallisierung (7) durch Aufbringen einer Aluminiumpaste, mit Aussparungen im Bereich der Rückseitenkontakte (3) im Siebdruckverfahren aufgebracht. Die Aluminiumpaste wird ebenfalls getrocknet. Anschließend 30 kommt es bei einem so genannten Firing-Prozess mit Temperaturen von oberhalb 700 Grad Celsius zu einer Legierungsbildung zwischen dem Aluminium der Aluminiumpaste und dem Silizium der Solarzelle (1), die zu einer erwünschten und für die Funktion der Solarzelle (1) notwendigen Dotierung 35 des Siliziums führt.

WO 2012/010314 10 PCT/EP2011/003668

Bei einem Beschichtungsverfahren mit einem
Niedertemperaturplasma (vgl. Figur 2) wird indes zunächst die
Rückseitenmetallisierung (7) aus Aluminium vollflächig auf
die Rückseite (2) des Siliziums der Solarzelle (1)

5 aufgebracht. Nach dem Trocknen und dem Einlegieren des
Aluminiums in das Silizium wird eine metallische Schicht (11)
zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes (3) mit Hilfe eines
nachfolgend anhand von Figur 4 näher erläuterten
Beschichtungsverfahrens bereichsweise auf die

10 Rückseitenmetallisierung aufgebracht.

Die metallische Schicht (11) wird im dargestellten Ausführungsbeispiel streifenförmig auf der Rückseitenmetallisierung (7) abgeschieden.

15

Das in Figur 3 dargestellte erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle (1) zeichnet sich dadurch aus, dass die Rückseitenmetallisierung (7) mit mindestens einer bis zur Rückseite (2) der Solarzelle (1) reichenden Öffnung 20 (8, 9) aufgebracht wird. Das Aufbringen der Rückseitenmetallisierung mit der Öffnung (8) bzw. den Öffnungen (9) kann beispielsweise im Wege eines Siebdruckverfahrens erfolgen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Rückseitenmetallisierung (7) zunächst vollflächig 25 auf die Rückseite (2) aufzubringen und anschließend die Öffnung(en) (8, 9) durch Abtragen der Rückseitenmetallisierung (7) einzubringen. Werden die Öffnungen (8, 9) erst nach dem Aufbringen der Rückseitenmetallisierung und Abschluss des Firing-Prozesses eingebracht, können Beeinträchtigungen der Effizienz der 30 Solarzelle durch die Öffnungen vollständig ausgeschlossen werden.

In dem in Figur 3 a), e) dargestellten Ausführungsbeispiel 35 ist jedem Rückseitenkontakt (3) genau eine längliche Öffnung (8) zugeordnet, deren Querschnittsfläche deutlich kleiner als WO 2012/010314 11 PCT/EP2011/003668

die Querschnittsfläche des Rückseitenkontaktes (3) (vgl. Figuren 3 b), 3 a)) ist.

- Figur 3 c) zeigt eine Ausführungsform, bei der jedem

  Rückseitenkontakt mehrere Öffnungen (9) in der
  Rückseitenmetallisierung (7) zugeordnet sind. Gegenüber der
  Fläche des Rückseitenkontaktes ist die Summe der
  Querschnittsflächen der Öffnungen (9) noch einmal kleiner, so
  dass die Effizienz der Solarzelle (1) durch die nicht mit
  einer Rückseitenmetallisierung (7) versehenen Bereiche
  unabhängig vom Zeitpunkt des Firing-Prozesses praktisch nicht
  beeinträchtigt wird.
- Beim anschließenden Aufbringen der metallischen Schicht (11)

  zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes (3) wird Metall in den Öffnungen (8 bzw. 9) abgeschieden und der durch die Öffnungen (8, 9) bis zur Rückseite (2) reichende Durchbruch gefüllt. Hierdurch wird der Rückseitenkontakt (3) an der Rückseite (2) der Solarzelle (1) verankert. Diese Verankerung kann abhängig von der verwendeten Aluminiumpaste zur Herstellung der Rückseitenmetallisierung (7) erforderlich sein, um stabile Lötverbindungen an den Rückseitenkontakten (3) zu ermöglichen.
- Figur 4 zeigt eine Vorrichtung zur Beschichtung der Rückseitenmetallisierung (7) der Solarzelle (1) unter Verwendung eines Strahls (10) eines Niedertemperaturplasmas, um die metallische Schicht (11) zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes (3) abzuscheiden. Die Vorrichtung umfasst einen Strahlgenerator (12) zur Erzeugung des gebündelten Strahls (10), der durch Entladung (13) unter Zufuhr eines Arbeitsgases (14) ausgebildet wird. Der Strahlgenerator (12) umfasst eine Stiftelektrode (15), die konzentrisch ein hohlzylindrischer, gegenüber der Stiftelektrode (15) isolierter, rohrförmiger Mantel (16) aus elektrisch leitfähigem Material umgibt. Der Mantel (16) weist an der

WO 2012/010314 12 PCT/EP2011/003668

unteren Stirnseite einen sich konisch zu einer Düsenöffnung (17) verjüngenden Bereich auf. An der gegenüberliegenden Stirnseite weist der hohlzylindrische Mantel (16) eine Zufuhr für das Arbeitsgas (14) auf, die mit einer nicht dargestellten Gasversorgung, insbesondere einer Druckluftversorgung verbunden ist.

Im Bereich der Düsenöffnung (17) befindet sich quer zur Ausbreitungsrichtung des Strahls (10) eine Einspeisung (18)

10 für ein Pulver-/Gasgemisch (22). Das Pulver-/Gasgemisch (22) wird unter Zufuhr eines weiteren Fördergases (19) in einem Behälter (20) durch Verwirbelung erzeugt und von dort der Einspeisung (18) zugeführt. Bei dem Pulver handelt es sich um metallisches Pulver zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes

15 (3). Das Pulver-/Gasgemisches (22) gelangt über die Einspeisung (18) in den Strahl (10) des

Niedertemperaturplasmas, der unter atmosphärischen Bedingungen das metallische Pulver auf die Rückseitenmetallisierung aufbringt.

20

5

Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn der Strahlgenerator (12) mit einer gepulsten Gleichspannungsquelle (23) mit einer Betriebsspannung zwischen 500 V bis 7 kV arbeitet. Die Pulsfrequenz liegt insbesondere zwischen 10 bis 100 kHz. Der Beschichtungsprozess wird vorzugsweise derart gesteuert, dass der Strahl (10) des Niedertemperaturplasmas in der Kernzone (21) eine Gastemperatur von weniger als 900 Grad Celsius, insbesondere jedoch von weniger als 500 Grad Celsius aufweist.

30

Der Abscheideprozess führt zu einer gut haftenden und elektrisch gut leitenden Verbindung, zwischen dem derart abgeschiedenen Rückseitenkontakt (3) und der Rückseitenmetallisierung (7). WO 2012/010314 13 PCT/EP2011/003668

#### Bezugszeichenliste

Nr.	Bezeichnung
1	Solarzelle
2	Rückseite
3	Rückseitenkontakt
4	Vorderseite
5	Vorderseitenkontakt
6	Kontaktfinger
7	Rückseitenmetallisierung
8	Öffnung
9	Öffnungen
10	Strahl
11	metallische Schicht
12	Strahlgenerator
13	Entladung
14	Arbeitsgas
15	Stiftelektrode
16	Mantel
17	Düsenöffnung
18	Einspeisung
19	Fördergas
20	Behälter
21	Kernzone
22	Pulver-/Gasgemisch
23	Spannungsquelle

WO 2012/010314 14 PCT/EP2011/003668

#### Patentansprüche

5

10

20

25

- 1. Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit einer aktiven, der Sonne zugewandten Vorderseite und einer Rückseite, die mindestens einen Rückseitenkontakt aufweist, umfassend
  - zunächst das Aufbringen einer
     Rückseitenmetallisierung auf die der Sonne
     abgewandete Rückseite der Solarzelle und
  - das anschließende bereichsweise Aufbringen einer metallischen Schicht auf die Rückseitenmetallisierung zur Ausbildung mindestens eines Rückseitenkontaktes,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

- die metallische Schicht (11) zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes (3) mit Hilfe eines Verfahrens zur Beschichtung einer Oberfläche unter Verwendung eines Strahls (10) eines Niedertemperaturplasmas bereichsweise aufgebracht wird und
- die Rückseitenmetallisierung (7) mit mindestens einer bis zur Rückseite der Solarzelle (1) reichenden Öffnung (8, 9) aufgebracht wird, wobei jedem Rückseitenkontakt (3) mindestens eine Öffnung (8) zugeordnet wird.
- Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit einer aktiven, der Sonne zugewandten Vorderseite und einer Rückseite, die mindestens einen Rückseitenkontakt aufweist, umfassend
- zunächst das Aufbringen einer
  35 Rückseitenmetallisierung auf die der Sonne abgewandete Rückseite der Solarzelle und

WO 2012/010314 15 PCT/EP2011/003668

 das anschließende bereichsweise Aufbringen einer metallischen Schicht auf die Rückseitenmetallisierung zur Ausbildung mindestens eines Rückseitenkontaktes,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

5

10

15

20

25

30

35

- die metallische Schicht (11) zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes (3) mit Hilfe eines Verfahrens zur Beschichtung einer Oberfläche unter Verwendung eines Strahls (10) eines Niedertemperaturplasmas bereichsweise aufgebracht wird und
- die Rückseitenmetallisierung (7) vollflächig auf die Rückseite (2) aufgebracht wird und vor dem Aufbringen der Schicht (11) zur Ausbildung des Rückseitenkontakts (3) mindestens eine bis zur Rückseite (2) der Solarzelle (1) reichende Öffnung (8, 9) in die Rückseitenmetallisierung (7) eingebracht wird, wobei jedem Rückseitenkontakt (3) mindestens eine Öffnung (8) zugeordnet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die metallische Schicht (11) zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes (3) jede Öffnung (8, 9) vollständig

überdeckend aufgebracht wird.

- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere metallische Schichten (11) übereinander zur Ausbildung des Rückseitenkontaktes (3) auf die Rückseitenmetallisierung (7) aufgebracht werden.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahl (10) des
  Niedertemperaturplasmas in der Kernzone (21) eine
  Gastemperatur von weniger als 900 °C, insbesondere von weniger als 500 °C aufweist.

WO 2012/010314 16 PCT/EP2011/003668

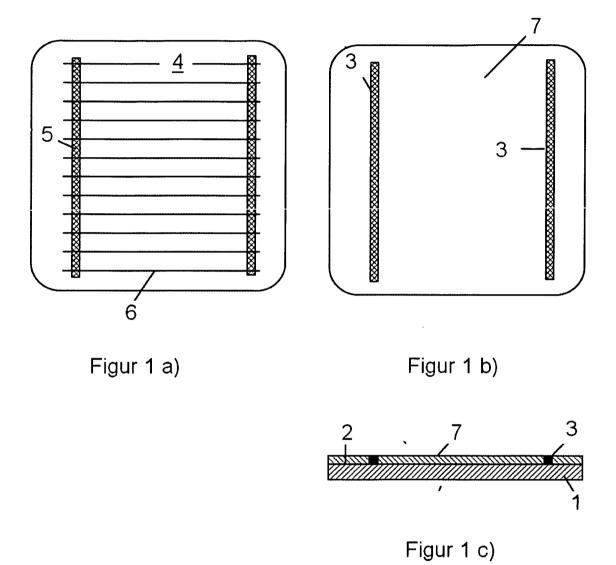
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Niedertemperaturplasma ein atmosphärisches Plasma ist.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass als Material zur Herstellung der Solarzelle (1) Silizium verwendet wird.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch

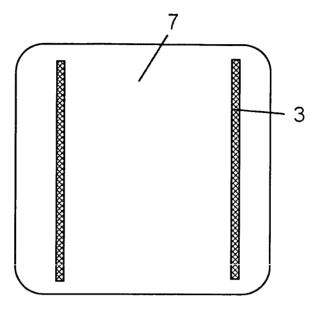
  gekennzeichnet, dass als Material zur Herstellung der
  Rückseitenmetallisierung (7) Aluminium aufgebracht wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ausbildung jedes
   Rückseitenkontaktes (3) eines der Metalle Zinn, Silber, Zink, Kupfer oder Mischungen der vorgenannten Metalle aufgebracht werden.
- 10. Solarzelle mit einer aktiven, der Sonne zugewandten

  Vorderseite und einer Rückseite, die mindestens einen auf
  einer Rückseitenmetallisierung (7) angeordneten
  Rückseitenkontakt aufweist, wobei jedem Rückseitenkontakt
  (3) mindestens eine Öffnung (8) in der
  Rückseitenmetallisierung zugeordnet ist, dadurch

  gekennzeichnet, dass die Fläche des Rückseitenkontaktes
  (3) die Querschnittsfläche sämtlicher ihm zugeordneten
  Öffnungen mindestens um den Faktor 2 übersteigt.
- 30 11. Solarzelle herstellbar durch ein Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10.

WO 2012/010314

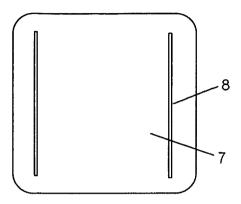




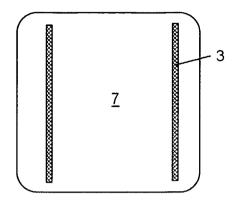
Figur 2 a)



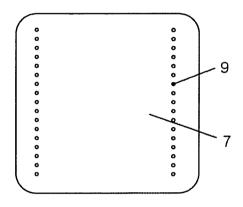
Figur 2 b)



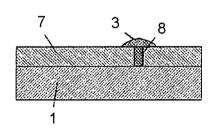
Figur 3 b)



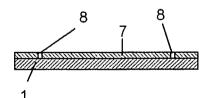
Figur 3 a)



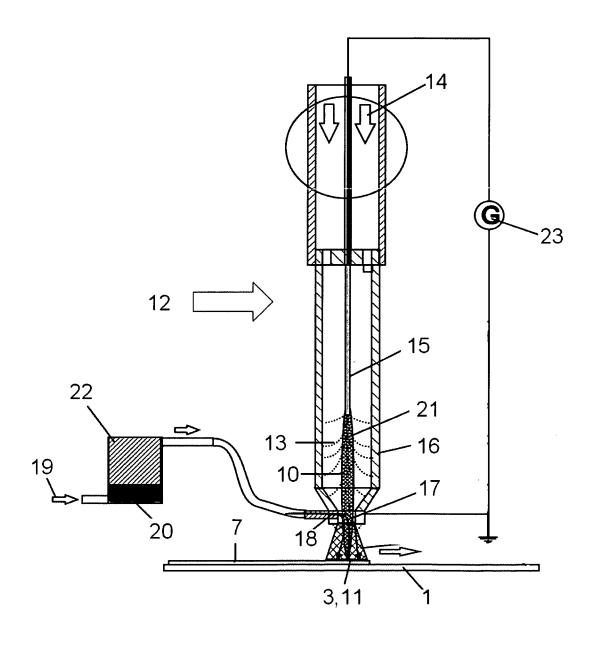
Figur 3 c)



Figur 3 e)



Figur 3 d)



Figur 4

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2011/003668

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. H01L31/0224 C23C4/12 ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01L C23C H05K H05H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Υ	US 2001/035129 A1 (CHANDRA MOHAN [US] ET AL) 1 November 2001 (2001-11-01) paragraph [0006]; figure 2 paragraph [0026] - paragraph [0028] paragraph [0032]	1-9,11		
Υ	WO 2005/031026 A1 (DVORAK MICHAEL [CH]) 7 April 2005 (2005-04-07) the whole document	1-9,11		
Υ	US 5 118 362 A (ST ANGELO DAVID A [US] ET AL) 2 June 1992 (1992-06-02) abstract; figure 9	4		
A	DE 198 07 086 A1 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) 26 August 1999 (1999-08-26) the whole document	1-11		

X Further documents are listed in the continuation of Box C.	X See patent family annex.			
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report			
5 December 2011	14/12/2011			
Name and mailing address of the ISA/  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Lantier, Roberta			

1

#### **INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No
PCT/EP2011/003668

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  DE 10 2008 051921 A1 (GFE FREMAT GMBH [DE]; INTERPANE ENTW & BERATUNGSGES [DE])  14 May 2009 (2009-05-14) paragraph [0050] - paragraph [0063];  figure 3	Relevant to claim No.  1-11

1

#### **INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2011/003668

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 2001035129	A1	01-11-2001	NON	NE .		•
WO 2005031026	A1	07-04-2005	AT CH EP ES JP WO	468418 T 696811 A 1675971 A 2345986 T 2007521395 A 2005031026 A	15 11 3	15-06-2010 14-12-2007 05-07-2006 07-10-2010 02-08-2007 07-04-2005
US 5118362	Α	02-06-1992	AU CA EP JP US WO	644021 B 8632491 A 2070420 A 0502155 A 2828341 B H05502556 A 5118362 A 9205587 A	1 11 11 32	02-12-1993 15-04-1992 25-03-1992 09-09-1992 25-11-1998 28-04-1993 02-06-1992 02-04-1992
DE 19807086	A1	26-08-1999	DE WO	19807086 A 9942637 A		26-08-1999 26-08-1999
DE 102008051921	A1	14-05-2009	DE EP US WO	102008051921 A 2179426 A 2010326512 A 2009056235 A	\2 \1	14-05-2009 28-04-2010 30-12-2010 07-05-2009

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2011/003668

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. H01L31/0224 C23C4/12 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  $H01L \quad C23C \quad H05K \quad H05H$ 

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

#### C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	US 2001/035129 A1 (CHANDRA MOHAN [US] ET AL) 1. November 2001 (2001-11-01) Absatz [0006]; Abbildung 2 Absatz [0026] - Absatz [0028] Absatz [0032]	1-9,11
Υ	WO 2005/031026 A1 (DVORAK MICHAEL [CH]) 7. April 2005 (2005-04-07) das ganze Dokument	1-9,11
Υ	US 5 118 362 A (ST ANGELO DAVID A [US] ET AL) 2. Juni 1992 (1992-06-02) Zusammenfassung; Abbildung 9	4
A	DE 198 07 086 A1 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) 26. August 1999 (1999-08-26) das ganze Dokument	1-11

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
  "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitalied derselben Patentfamilie ist

dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	a veronentiichung, die Mitglied derseiben Fatentiannile ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts		
5. Dezember 2011	14/12/2011		
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter		
Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Lantier, Roberta		

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2011/003668

ategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
ategorie Bezeiehnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile  DE 10 2008 051921 A1 (GFE FREMAT GMBH [DE]; INTERPANE ENTW & BERATUNGSGES [DE]) 14. Mai 2009 (2009-05-14) Absatz [0050] - Absatz [0063]; Abbildung 3	Betr. Anspruch Nr.  1-11

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2011/003668

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 2001035129	A1	01-11-2001	KE:	INE		
W0 2005031026	A1	07-04-2005	AT CH EP ES JP WO	468418 696811 1675971 2345986 2007521395 2005031026	A5 A1 T3 A	15-06-2010 14-12-2007 05-07-2006 07-10-2010 02-08-2007 07-04-2005
US 5118362	Α	02-06-1992	AU CA EP JP US WO	2070420	A A1 A1 B2 A A	02-12-1993 15-04-1992 25-03-1992 09-09-1992 25-11-1998 28-04-1993 02-06-1992 02-04-1992
DE 19807086	A1	26-08-1999	DE WO	19807086 9942637		26-08-1999 26-08-1999
DE 102008051921	A1	14-05-2009	DE EP US WO	102008051921 2179426 2010326512 2009056235	A2 A1	14-05-2009 28-04-2010 30-12-2010 07-05-2009